

مدلاتور پلاسمونیک ترکیبی الکترو جذبی Al/p-Si سازگار با CMOS

رضا کوهستانیان^۱، سیده مهری حمیدی^۱، آرش یزدانپناه گوهرریزی^۲

^۱آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

^۲دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده: هدف این تحقیق طراحی مدولاتور مینیاتوری پلاسمونیک ترکیبی Al/p-Si سازگار با CMOS با کاهش توان مصرفی در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر است. بر این اساس، مدولاتور n-p-n با افزایش ناخالصی نیمه هادی سیلکون و به کمک روش تفاضل محدود در حوزه زمان، با ابعاد یک میکرومتر شبیه سازی شده است. با افزایش ناخالصی نیمه هادی سیلکون و با استفاده از خواص فلزی ایجاد شده در آن، مدلهای پلاسمونیک پشتیبانی شده و عملیات مدولاسیون صورت می پذیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر ضریب خاموشی ۷/۷۴ دسی بل و تلفات الحاقی ۲/۴۲ دسی بل و ولتاژ کاری بین صفر تا ۲/۳ ولت است که می تواند در راستای طراحی مدولاتورهای کم توان و مینیاتوری مفید باشد.

کلید واژه: مدولاتور، پلاسمونیک، نرخ خاموشی، تلفات الحاقی

Hybrid Plasmonic Electro-Absorption Al/P-Si compatible with CMOS

Reza Kouhestanian^{1,2}, Seyedeh Mehri Hamidi¹, and Arash Yazdanpanah Goharrizi²

¹ Magnetoplasmonic Lab, Laser and Plasma Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

² Department of Electrical Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran

Abstract: The purpose of this research is to design a miniature hybrid plasmonic Al/p-Si compatible with CMOS with reduction power consumption at telecommunication wavelength 1550 nm. For this aim, n-p-n modulator with highly doped silicon was simulated by employing the finite difference time domain method. Using the metallic properties of silicon created by increasing the concentration of dopants, the plasmonic modes are supported and modulation operation is performed. According to the simulation results of this work, the extinction ratio and insertion loss are obtained as 7.74dB and 2.42dB respectively, furthermore the operation voltage is chosen between 0 to 2.3 Volts. Therefore, the proposed structure can be useful for designing the miniature and low consumption power modulators.

Keywords: Modulator, Plasmonics, Extinction ratio, Insertion loss

۱- مقدمه

در سال های گذشته صنایع نیمه‌هادی شروع به کوچک سازی ابعاد ترانزیستورها در راستای افزایش فرکانس عملیاتی نموده‌اند. طبق قانون مور^۱ تعداد ترانزیستورها بر روی یک تراشه یکسان با قیمت ثابت هر دو سال بایستی دو برابر گردد [۱]. چالش‌های موجود در سر راه کاهش ابعاد افزاره‌های الکترونیکی، کاهش فرکانس عملیاتی این ادوات را در پی دارد. در این راستا، راه‌حلهایی برای افزایش فرکانس عملیاتی پیشنهاد شده است که یکی از آنها استفاده از فوتونیک بر پایه سیلیکون است. متأسفانه کوچک‌سازی این قطعات فوتونیک به دلیل حد پراش^۲ محدود است. بنابراین مجتمع سازی این قطعات با مدارات الکترونیک مدرن به دلیل عدم تطابق اندازه سخت است. برای حل این مشکل از علم پلاسمونیک بهره می‌گیرند که در آن مدهای پلاسمونیک می‌توانند بر این حد پراش فائق آیند. مجموعه‌ای از ادوات پلاسمونیک فعال از قبیل موجرها، منبع‌ها، آشکارسازها و ... در طول دهه‌های اخیر پیشنهاد شده‌اند [۲]. در این مقاله یکی از ادوات پلاسمونیک به نام مدولاتور که وظیفه سوار کردن اطلاعات بر روی نور را بر عهده دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

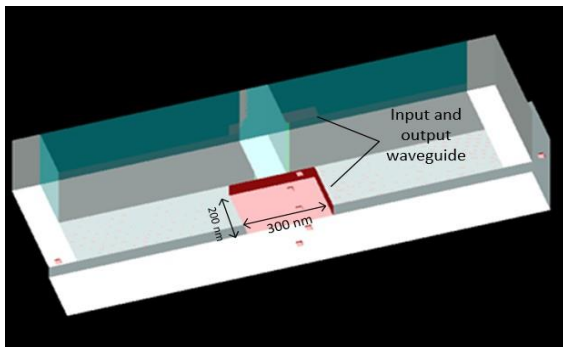
۲- ساختار ارائه شده

ساختار ارائه شده در اینجا یک مدولاتور پلاسمونیک ترکیبی Al/p-Si سازگار با سی ماس^۳ است که در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر کار می‌کند. این ساختار که از الکترودهای Al و موجر n-p-n بر پایه سیلیکون تشکیل شده است، در این تحقیق مورد مطالعه و شبیه‌سازی توسط نرم افزار لومریکال قرار می‌گیرد. در این ساختار نوار p-Si به عنوان لایه نزدیک به فلز با ثابت دی الکتریک نزدیک به صفر^۴ [۳] عمل می‌کند.

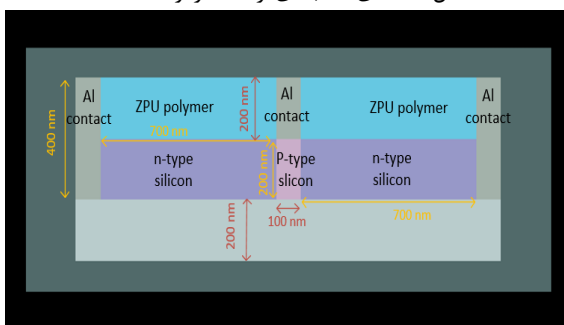
۲-۱ طراحی مدولاتور:

ساختار مدولاتور در نماهای دو و سه بعدی در شکل‌های

۱ و ۲ نمایش داده شده است.



شکل ۱: نمای سه بعدی از ساختار ارائه شده



شکل ۲: نمای دوبعدی از سطح مقطع برش داده شده از روبه روی مدولاتور

همانطور که در شکل ۱ و ۲ نمایش داده شده است الکترودهای آلومینیومی در بالای ناحیه سیلیکون با ناخالصی P با ابعاد $width \times height = 100 \times 200 \text{ nm}^2$ و در مجاورت سیلیکون‌های با ناخالصی نوع n با ابعاد $width \times height = 100 \times 400 \text{ nm}^2$ قرار گرفته‌اند. لایه بالای ناخالصی‌های نوع n از نوع پلیمر ZPU-44 است، ضریب شکست پلیمر، SiO_2 ، Si، و آلومینیوم در طول موج ۱/۵۵ میکرومتر به ترتیب ۱/۴۴، ۱/۴۴۶، ۳/۴۸ و $1.514 + 15.234i$ می‌باشد.

یک مد پایه TE در موجر سیلیکونی با ابعاد $width \times height = 300 \times 200 \text{ nm}^2$ شروع به انتشار می‌نماید، نور عبوری از این موجر باعث تحریک مدهای پلاسمونیک از طریق جفت شوندگی صورت به صورت^۵ به موجر ترکیبی پلاسمونیک می‌شود. پیوند n-p-n شامل ناحیه P با ابعاد $width \times height = 100 \times 200 \text{ nm}^2$ و

^۱Moore's law

^۲Diffraction limit

^۳Complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)

^۴ε - Near - zero (ENZ)

^۵Face to face

ناخالصی بالای $1 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ است. این ناحیه به عنوان هسته بین نواحی سیلیکونی با ناخالصی نوع n که دارای ابعاد $\text{width} \times \text{height} = 700 \times 200 \text{ nm}^2$ با ناخالصی $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ می باشد قرار گرفته است. کل ناحیه سیلیکون بر روی لایه SiO_2 با ابعاد $\text{width} \times \text{height} = 1500 \times 200 \text{ nm}^2$ قرار گرفته است. توزیع و ضریب شکست مؤثر مدهای پلاسمون پلاریتون سطحی^۱ با تغییر ثابت دی الکتریک سیلیکون با به کار بردن ناخالصی نوع n و p تغییر می کند [۴] که این اثر اساس کار مدولاتور ارائه شده را تشکیل می دهد. بعد از عمل مدولاسیون، در موجبر خروجی مدهای پلاسمون پلاریتون سطحی به مدهای نوری تبدیل می گردند.

۲-۲- تئوری آنالیزهای انجام گرفته

عمل مدولاتورهای الکترومغناطیسی بر پایه سیلیکون معمولاً بر اثر پاشندگی پلاسمای بارهای آزاد می باشد. که این روش معمول ترین روش برای تغییر دادن ضریب شکست در نیمه هادی ها است. روابط ۱ و ۲ تغییرات ضریب شکست Δn و ضریب جذب $\Delta \alpha$ را با تغییرات غلظت الکترون و حفره $(\Delta N_e \text{ و } \Delta N_h)$ بیان می کند:

$$\Delta n = -\left(\frac{e^2 \lambda^2}{8\pi^2 c^2 \epsilon_0 n}\right) \left[\Delta N_e / m_{ce}^* + \Delta N_h / m_{ch}^*\right] \quad (۱)$$

$$\Delta \alpha = -\left(\frac{e^3 \lambda^2}{4\pi^2 c^3 \epsilon_0 n}\right) \left[\Delta N_e / m_{ce}^* \mu_e + \Delta N_h / m_{ch}^* \mu_h\right] \quad (۲)$$

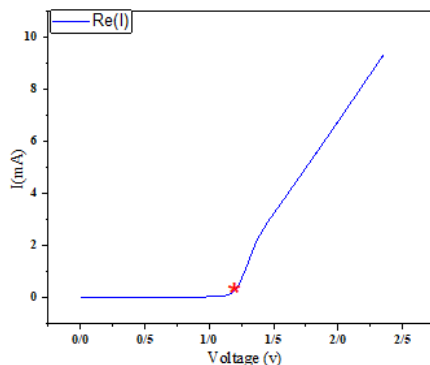
که در آن e بار الکترون، ϵ_0 ثابت دی الکتریک در خلأ، n ضریب شکست سیلیکون بدون ناخالصی، m_{ce}^* جرم مؤثر الکترون و m_{ch}^* جرم مؤثر حفره، μ_e موبیلیتی الکترون و μ_h موبیلیتی حفره می باشد.

روابط ۱ و ۲ فقط برای شرایطی که ناخالصی اضافه شده به سیلیکون کم باشد صادق است. زمانی که چگالی حامل ها در سیلیکون بالا باشد (بزرگتر از 10^{18} cm^{-3}) قسمت حقیقی ثابت دی الکتریک سیلیکون منفی می گردد. در نتیجه محاسبه ضریب شکست سیلیکون (که در آن $\tilde{\epsilon} = \epsilon_1 - i\epsilon_2$ ثابت دی الکتریک می باشد) از رابطه ۳ تبعیت می کند:

$$\tilde{n}^2 = \tilde{\epsilon} = \epsilon_{Si} - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\Gamma)} \quad (۳)$$

۲-۳- مشخصه های الکتریکی و نوری

شبیه سازی بخش الکتریکی توسط نرم افزار Device از خانواده لومریکال انجام شده است. شکل ۳ مشخصه ولتاژ-جریان را برای پیوند n-p-n نمایش می دهد که بیانگر افزایش جریان در ولتاژ ۱/۲ ولت است.



شکل ۳: مشخصه ولتاژ-جریان برای پیوند n-p-n
تلفات الحاقی^۴ بدست آمده برای این ساختار با جاروب کردن ولتاژ از صفر تا ۲/۴ ولت مقدار ۲/۴۲ دسی بل بدست آمد که از رابطه ۴ تبعیت می کند:

$$IL = 10 \log \left(\frac{I_{\max}}{I_0} \right) \quad (۴)$$

I_0 و $I_{\max}$ مقدار شدت نور خروجی ماکزیم عبوری در مدولاتور و شدت نور منبع ورودی می باشند. همچنین مقدار نرخ خاموشی^۵ برای این ساختار ۷/۷۴ دسی بل بدست آمده است که از فرمول زیر تبعیت می کند.

$$ER = 10 \log \left(\frac{I_{\max}}{I_{\min}} \right) \quad (۵)$$

^۱Relaxation time

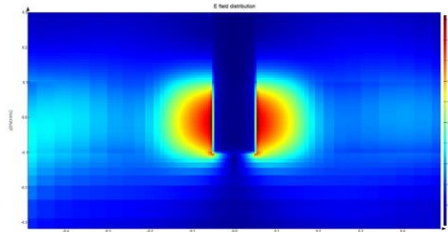
^۲Insertion loss

^۳Extinction ratio

^۱Surface plasmon polariton (spp)

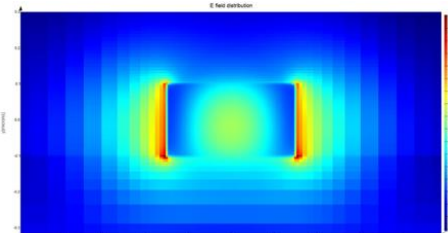
^۲Free carrier plasma dispersion effect

روی مدهای پلاسمون سطحی تاثیر گذاشته و باعث کاهش شدت نور در خروجی مدولاتور می شود. طی این عملیات عمل مدولاسیون نور انجام می گیرد.



شکل ۷: پلاسمون تشکیل شده در داخل مدولاتور در ولتاژ اعمالی

۲/۳ ولت



شکل ۸: توزیع میدان الکتریکی در خروجی مدولاتور با ولتاژ اعمالی

۲/۳ ولت

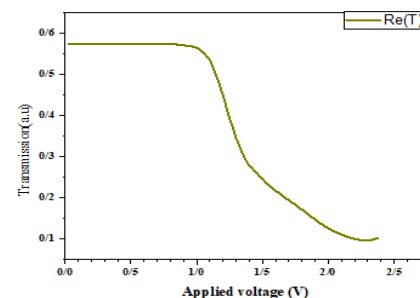
نتیجه گیری

در این مقاله با استفاده از تشکیل مدهای پلاسمون سطحی توانستیم مدولاتوری سازگار با سی ماس طراحی کنیم. با توجه به نتایج شبیه سازی برای پارامترهای کلیدی مدولاتور که شامل نرخ خاموشی، تلفات الحاقی و جایگیری قطعه می باشند، به ترتیب مقادیر ۷/۷۴ دسی بل، ۲/۴۲ دسی بل و حدود یک میکرومتر حاصل شد.

مراجع

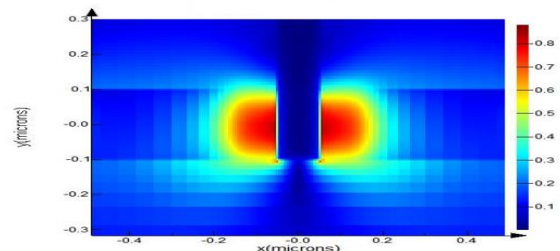
- [۱] G. E. Moore, "Cramming More Components Onto Integrated Circuits, Electronics, (38) 8," ed: April, 1965.
- [۲] D. K. Gramotnev and S. I. Bozhevolnyi, "Plasmonics beyond the diffraction limit," *Nature photonics*, vol. 4, pp. 83-91, 2010.
- [۳] Z. Lu, W. Zhao, and K. Shi, "Ultracompact Electroabsorption Modulators Based on Tunable Epsilon-Near-Zero-Slot Waveguides," *IEEE Photon. J.*, 2012.
- [۴] Z. Qi, G. Hu, L. Li, B. Yun, R. Zhang, and Y. Cui, "Design and Analysis of a Compact SOI-Based Aluminum/Highly Doped p-Type Silicon Hybrid Plasmonic Modulator," *IEEE Photonics Journal*, vol. 8, pp. 1-11, 2016.

I_{min} شدت نور خروجی مینیمم است که در ولتاژ ۲/۳ ولت اتفاق می افتد (شکل ۴).

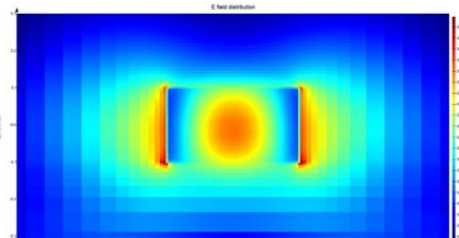


شکل ۴: نمودار عبور نور از مدولاتور از ولتاژ صفر تا ۲/۴ ولت.

جهت اثبات تشکیل مدهای پلاسمونیک در نمونه، توزیع میدان الکتریکی در داخل مدولاتور و همچنین خروجی آن به ترتیب در شکل های ۵ و ۶ در ولتاژ صفر ولت ثبت شده است.



شکل ۵: توزیع میدان الکتریکی در داخل مدولاتور که نشان دهنده جفت شدن نور به داخل مدولاتور و تشکیل پلاسمون سطحی است.



شکل ۶: توزیع میدان الکتریکی در خروجی مدولاتور در ولتاژ اعمالی صفر ولت.

از سوی دیگر، توزیع میدان الکتریکی در داخل مدولاتور و همچنین خروجی آن به ترتیب در شکل های ۷ و ۸ در ولتاژ ۲/۳ ولت نشان داده شده است.

بالا بودن ناخالصی ناحیه p باعث ایجاد خاصیت فلزی در این ناحیه شده، در نتیجه با جفت شدن نور بین این ناحیه و ناحیه n امواج پلاسمون سطحی تشکیل می گردد که در امتداد ناحیه فعال مدولاتور انتشار می یابد. با اعمال ولتاژ به مدولاتور، حفره ها به ناحیه n نفوذ کرده و باعث تغییر ضریب شکست در نواحی n و p می شوند. این عمل بر